

3SK60

シリコンNチャンネルデュアルゲートMOS FET

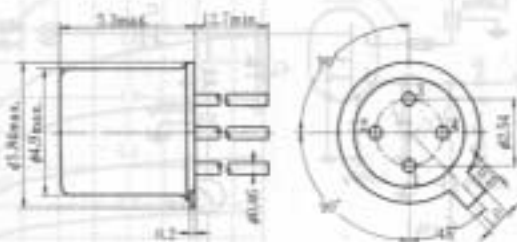
SILICON N-CHANNEL DUAL GATE MOS FET

VHF 高周波増幅用

VHF AMPLIFIER

VHF TV チューナ高周波増幅用

VHF TV TUNER RF AMPLIFIER



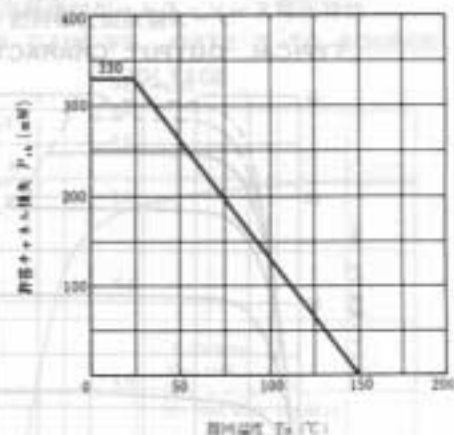
1. ドレイン : Drain
 2. ゲート2 : Gate 2
 3. ゲート1 : Gate 1
 4. ソース : Source
- (ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)

(JEDEC TO-72)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	3SK60	Unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DS}		15	V
ゲート1・ソース電圧	V_{G1S}		± 8	V
ゲート2・ソース電圧	V_{G2S}		± 8	V
ドレイン電流	I_D		33	mA
許容チャネル損失	P_{ch}		330	mW
チャネル温度	T_{ch}		150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}		$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

■ 許容チャネル損失の周囲温度による変化 MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
ゲート1・ソース遮断電圧	$V_{GS(off)}$		$V_{DS}=10\text{V}, I_D=100\mu\text{A}, V_{GS}=3\text{V}$	0	—	-1.7	V
ゲート2・ソース遮断電圧	$V_{GS2(off)}$		$V_{DS}=10\text{V}, I_D=100\mu\text{A}, V_{GS}=3\text{V}$	—	—	-1.1	V
ゲート1遮断電流	I_{GS1}		$V_{GS}=\pm 8\text{V}, V_{DS}=V_{GS}=0$	—	—	± 20	nA
ゲート2遮断電流	I_{GS2}		$V_{GS}=\pm 8\text{V}, V_{DS}=V_{GS}=0$	—	—	± 20	nA
ドレイン電流	I_{DSS}		$V_{DS}=6\text{V}, V_{GS}=0, V_{GS}=3\text{V}$	—	—	12	mA
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $		$V_{DS}=6\text{V}, I_D=10\text{mA}, V_{GS}=3\text{V}, f=1\text{kHz}$	11	16	—	mS
入力容量	C_{in}		$V_{DS}=6\text{V}, I_D=10\text{mA}, V_{GS}=3\text{V}, f=1\text{MHz}$	—	—	5.0	pF
出力容量	C_{out}			—	—	2.5	pF
逆伝達容量	C_{iss}			—	0.015	—	pF
電力利得	PG		$V_{DS}=6\text{V}, I_D=10\text{mA}$	20	24	—	dB
雑音指数	NF		$V_{GS}=3\text{V}, f=200\text{MHz}$	—	2.0	3.0	dB